

*К 100- летию со дня рождения
профессора Б.Т. Коломийца*

**Программа VI Международной конференции
«Аморфные и микрокристаллические полупроводники»**

7 июля

Пленарное заседание

9:45 Открытие конференции. Председатель оргкомитета Е.И. Теруков

В.И. Иванов-Омский. Вступительное слово о Б.Т.Коломийце

10:15 Коломийцевская лекция. В.Г. Голубев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Высококонтрастные фотонные кристаллы на основе аморфно-нанокристаллического кремния и родственных материалов

11:00 А.А. Андреев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Экскурс в историю и некоторые современные направления в физике аморфных полупроводников

11:30 A.M. Andriesh, M.S. Iovu

Center of Optoelectronics of the Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova

Diffraction and luminescent optical structures on the basis of chalcogenide glasses, polymers and rare-earth elements

12:00-12:20 кофе

12:20 A.V. Kolobov, P. Fons, J. Tominaga

Center for Applied-Near-Field Optics Research, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1-1-1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8562, Japan

Phase-change memory: recent progress in understanding the underlying mechanism

12:50 А.И. Попов

Московский энергетический институт (технический университет)

Память на фазовых переходах: как не наступить дважды на одни и те же грабли

13:20 Э.А. Лебедев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Неустойчивости тока с S и N-образными ВАХ, эффект переключения и памяти в ХСП и органических полимерах

14:00-15:00 обед

Секция А

Аморфный гидрогенизированный кремний и сплавы на его основе

15:00 **A.S. Gudovskikh¹, J.P. Kleider**

Laboratoire de Génie Électrique de Paris/Supélec (CNRS UMR8507), France

¹*A.F.Ioffe Physico-Technical Institute*

Electrical characterization of the a-Si:H/c-Si interface

15:20 **Т.Г. Авачева, Н.В. Бодягин, С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, К.В. Митрофанов**

Рязанский государственный радиотехнический университет

Определение степени упорядочения структуры поверхности материалов микро- и наноэлектроники

15:40 **А.Г. Казанский, Guanglin Kong¹, Xiangbo Zeng¹**

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

¹*Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China*

Электрические и оптические свойства пленок гидрированного кремния с двухфазной структурой

16:00-16:20 кофе

16:20 **А.А. Дукин, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, С. Sibilina*, Н.А. Феоктистов, В.Г. Голубев**

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

* *Universita' di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Energetica, Italy, Roma*

Резонансное возбуждение люминесценции ионов эрбия через собственные моды микрорезонатора на основе a-SiO_x:H/a-Si:H: теория и эксперимент

16:40 **О.Б. Гусев, Е.И. Теруков, Ю.К. Ундалов, К.Д. Цэндин**

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Дефектная фотолюминесценция аморфного кремния при сильном оптическом возбуждении

17:00 **В.А. Володин^{1,2}, М.Д. Ефремов^{1,2}, Г.А. Качурин¹, С.А. Кочубей¹, А.Г. Черков¹, М. Дойчман¹, Н. Баерш³**

¹*Институт физики полупроводников, Новосибирск*

²*Новосибирский госуниверситет, ул.Пирогова 2, Новосибирск*

³*Лазерный центр, Ганновер, Германия*

Фазовый переход аморфных пленок кремния при фемтосекундном лазерном воздействии

18:00 Welcome party

8 июля

**Секция В
Органические полупроводники**

9:30 А.Н. Алешин

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Квазиодномерный транспорт в проводящих полимерных нанопроводах

**9:50 А.В. Анкудинов, В.Л. Берковиц, А.Б. Гордеева, М.И. Дюков¹,
В.В. Егоров¹, А.К. Сироткин¹**

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*ГУ НИИ группа РАМН, Санкт-Петербург*
Исследование механических и электрических характеристик полипептидных нанопроволок

10:10 В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов

Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа
Эффекты электронного переключения в полимерных пленках, связь со структурой и морфологией

**10:30 Э.К. Алиджанов, О.А. Домахин, Ю.Д. Лантух, С.Н. Летуга, С.Н. Пашкевич,
И.Е. Кареев¹, В.П. Бубнов¹, Э.Б. Ягубский¹**

Оренбургский государственный университет
¹*Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия.*
Фотофизические свойства полимерных пленок МЕН-PPV в присутствии нанокластеров эндометаллофуллеренов

11:00-11:20 кофе

**Секция С
Аморфный углерод**

11:20 В.И. Иванов-Омский, Т.К. Звонарева

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
Аморфный углерод как матрица для формирования нанокластеров металлов

11:40 Р.Н. Грицкевич¹, Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук

БГУ, Минск
¹*НИЦ "Плазматек" ФТИ НАН Беларуси, Минск*
Синтез и электрофизические свойства нанокластерных медьсодержащих алмазоподобных пленок

**12:00 А.Б. Певцов¹, А.В. Акимов¹, У. Танака², С.Ф. Каплан¹, В.Г. Голубев¹,
S. Tamura¹, D. R. Yakovlev^{1,2}, M. Bayer³**

¹*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург*
²*Department of Applied Physics, Hokkaido University, Sapporo, Japan*
³*Experimentelle Physik II, Technische Universität Dortmund, Germany*
Гиперзвуковая модуляция света в трехмерных периодических структурах на основе аморфного оксида кремния

**12:20 А.М. Данишевский, Б.Д. Шанина¹, А.И. Вейнгер, Р.Н. Кютт,
А.А. Ситникова, С.К. Гордеев²**

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

¹*Институт физики полупроводников НАНУ, Киев*

²*Институт материалов, Санкт-Петербург*

Кластеры переходных металлов в нанопористом углероде

**12:40 A.V. Khomich, V.G. Ralchenko¹, I.I. Vlasov¹, M.V. Kanzyuba²,
N.A. Poklonski², N.I. Gorbachuk², R.A. Khmel'nitskii³, A.S. Trushin³**

V.A. Kotelnikov Institute of RadioEngineering & Electronics RAS, Fryazino

¹*A.M. Prokhorov General Physics Institute RAS, Moscow*

²*Belorussian State University, Physics Department, Minsk, Belarus*

³*P.N. Lebedev Physical Institute RAS, Moscow*

Optical and electrical properties of nitrogen-doped ultrananocrystalline diamond films

13:00-14:00 обед

Секция D

Нанокристаллические, пористые и кластерные материалы

14:00 В.А. Демин, Е.А. Константинова, П.К. Кашкаров

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

РНИЦ «Курчатовский институт», Москва

Люминесцентные свойства ансамблей связанных нанокристаллов кремния в рамках модели экситонной миграции

**14:20 М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, В.В. Лундин, Э.Ю. Даниловский,
Р.В. Кузьмин, Ю.В. Кожанова¹**

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*

Внутрицентровые f-f переходы РЗИ, зарядовое состояние легирующей примеси в структурах с квантовыми ямами на основе $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{GaN}$

14:40 С.К. Лазарук, А.В. Долбик, В.А. Лабунов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Влияние структурных параметров пористого кремния на процессы горения и взрыва

15:00 Е.А. Константинова, В.А. Демин, П.К. Кашкаров

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

РНИЦ «Курчатовский институт», Москва

Диагностика генерации синглетного кислорода в кремниевых нанокристаллах методом ЭПР-спектроскопии

15:20 Д.В. Бутурович, М.В. Кузьмин, М.В. Логинов, М.А. Митцев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

Размерные зависимости адсорбционно-каталитических свойств поверхности аморфных нанопленок иттербия, создаваемых на поверхности кремния Si (111)7x7

15:40-16:00 кофе

- 16:00** Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, Ю.С. Вайнштейн, О.М. Сресели
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Влияние генерации синглетного кислорода на фотолюминесценцию нанопористого кремния
- 16:20** А.Е. Бердников, А.А. Попов, А.А. Мироненко, В.Д. Черномордик
Ярославский филиал физико-технологического института РАН
Эффект памяти в SiO_x с включенными кластерами кремния
- 16:40** К.Б. Алейникова, Е.Н. Зинченко
Воронежский государственный университет
Новый метод анализа атомной структуры стеклообразных и дифракционноаморфных нанодисперсных полупроводников
- 17:00** С.А. Дьяков, Д.М. Жигунов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аморфные и кристаллические кремниевые квантовые точки как сенсibilизаторы энергии для ионов Er³⁺, находящихся в матрице диоксида кремния

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

16:00 – 19:00

9 июля

Секция Е

Халькогенидные и стеклообразные полупроводники

9:30 Б.А. Мелех, Л.А. Кулакова, В.И. Бахарев, В.Х. Кудоярова, С.А. Грудинкин
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН

Эвтектические теллуридные стёкла – ХСП с изменением структуры ближнего порядка при переходе «стекло- кристалл»: получение, электрические и оптические свойства, возможные приложения в акустооптике

**9:50 С.А. Козюхин², А.А. Шерченков¹, Е.В. Горшкова¹, В.Х.Кудоярова³,
А.И. Варгунин²**

Московский государственный институт электронной техники (технический университет), Зеленоград

²*Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН, Москва*

³*Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург*

Дифференциальная сканирующая калориметрия аморфных тонких пленок и кристаллического соединения $Ge_2Sb_2Te_5$

10:10 А.А. Бабаев, Р.А. Мурадов, С.Б. Султанов, А.М. Асхабов

Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского НЦ РАН

Механизм влияния примесей платины и золота на фотолюминесценцию и электропроводность стеклообразного сульфида мышьяка

10:30 В.Х. Кудоярова, С.А. Козюхин¹, В.М. Лебедев², К.Д.Цэндин

Физико-технический институт им. А. Ф.Иоффе РАН

¹*Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва*

²*Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН*

Исследование фотолюминесценции и состава аморфных пленок As_2S_3 модифицированных комплексным соединением $Eu(thd)_3$

10:50 С.А. Козюхин, Э.Н. Воронков

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва

¹*МЭИ (ТУ), Москва*

Анализ термо - полевых зависимостей электропроводности аморфных халькогенидных полупроводников

11:10- 11:30 кофе

11:30 Ш.Ш. Сарсембинов, О.Ю. Прихолько, А.П. Рягузов, С.Я. Максимова

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Структура и электронные свойства аморфных пленок мышьяксодержащих ХСП, полученных разными методами

11:50 Н.А. Богословский, К.Д. Цэндин¹

СПб ПГУ, Санкт-Петербург

¹*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург*

Многофононная туннельная ионизация U- минус центров как механизм ответственный за особенности записи информации в ячейках памяти из ХСП

12:10 Е.В. Школьников

Лесотехническая академия, Санкт-Петербург

О роли параметров вязкого течения в стеклообразовании и кристаллизации полупроводников

12:30 П.П. Серегин

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

Исследования халькогенидных стекол методом Мессбауэровской спектроскопии

12:50 В.С. Минаев, С.П. Тимошенко¹, В.В. Калугин¹, С.И. Ковалев¹

ЗАО «НИИ Материаловедения», Москва

¹*МИЭТ (ГУ), Москва*

Генетическая взаимосвязь кристаллического, жидкого и стеклообразного состояний и её проявление в термо- и фотоиндуцированных структурных превращениях в стеклообразующем веществе

13:10-14:10 обед

Секция F

Технические приложения

14:10 А.И. Гаврилюк

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

Нанокристаллические пленки оксидов переходных металлов для получения, хранения и транспорта водорода

14:30 А.А. Дукин, С.А. Грудинкин, С.Ф. Каплан, Д.А. Курдюков, В.Г. Голубев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

Синтез субмикронных монодисперсных сферических частиц SiO₂ и создание пленочных трехмерных фотонных кристаллов на основе композитов опал-а-Si для инфракрасного диапазона спектра

14:50 A. Kosarev, A. Torres, M. Moreno, I. Cosme

National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics, Mexico

Noise in micro-bolometers and non-crystalline films

15:10 Т.Л. Кулова¹, А.М. Скундин¹, Ю.В. Плесков¹, Е.И. Теруков, О.И. Коньков, И.Н. Трапезникова

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

¹*Институт физической химии и электрохимии РАН, Москва*

Аморфный гидрогенизированный кремний - отрицательный электрод в литиевых тонкопленочных батареях второго поколения

15:30 И.М. Котина, Л.М. Тухконен, Б.В. Спицын¹, А.Н. Блаут-Блачев¹, А.М. Ефременко², А.В. Корляков², В.В. Лучинин², В.И. Иванов³, Н.Б. Строкан³

ПИЯФ им. Б.П.Константинова РАН

¹*ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва*

²*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"*

³*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург*

Барьеры Шоттки с нанотолщинным диэлектриком из нанокристаллического нитрида алюминия

15:50 Г.Л. Пахомов, В.В. Рогов, М.Н. Дроздов, А.В. Мурель

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Фотогальванические ячейки на основе фталоцианинов с термически и магнетронно напылёнными Al контактами

16:10 - 16:30 кофе

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

16:00 – 18:00

**18:00 Круглый Стол
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ**

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

8 июля, 16:00

Секция А: Аморфный гидрогенизированный кремний и сплавы на его основе

- A01. В.Х. Кудоярова, Д.М. Жигунов¹, В.М. Лебедев², Е.И. Теруков**
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН
¹*Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова*
²*Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина, Ленинградская обл.*
Фотолюминесценция Er в аморфном карбиде кремния a-Si_{1-x}C_x:H<Er>, легированном эрбием из полимера Er(thd)₃
- A02. A. Kosarev, A. Torres, N. Delgadillo, G. Ramirez¹, Yu. Kudriavtsev¹, R. Asomoza¹**
Electronics, National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics, Mexico
¹*Dep. Ingenieria Electronica - SEES, Cinvestav-IPN, Mexico*
Phosphorus incorporation and its effect on electronic properties in Si_yGe_{1-y}:H films deposited by low frequency PECVD
- A03. M.M. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова¹, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Интенсивность излучения внутрицентровых f-f переходов примеси в полупроводниковых соединениях, легированных РЗИ (на примере пленок a-Si:H и вюрцитных кристаллов GaN)
- A04. А.П. Авачѐв, К.О. Аношкин, С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, И.Г. Уточкин**
Рязанский государственный радиотехнический университет
Влияние локализованных состояний a-Si:H на параметры тонкопленочного полевого транзистора в ключевом режиме работы
- A05. Т.Г. Авачева, С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, К.В. Митрофанов, И.Г. Уточкин**
Рязанский государственный радиотехнический университет
Исследование структурных особенностей пленок a-Si:H в зависимости от технологических режимов осаждения
- A06. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.М. Лебедев¹, В.Х. Кудоярова, И.Н. Трапезникова**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*ПИЯФ им. Константинова, Гатчина, Ленинградской обл.*
Связь состава пленок a-SiO_x:H<Er,O> и интенсивности фотолюминесценции ионов эрбия с изменениями электрического поля в dc-магнетроне

Секция В: Органические полупроводники

- В01. А.С. Комолов, Н.Б. Герасимова, Э.Ф. Лазнева, С.Н. Ахремчик, А.Ю. Осадчев¹, В.В. Шаманин¹**
Санкт-Петербургский Государственный Университет
¹*ИВС РАН, Санкт-Петербург*
Воздействие паров воды, толуола и аммиака на электропроводность пленок кремнийорганических полигомосопряженных полимеров
- В02. В.Х. Ильясов, А.Н. Лачинов¹, А.Ф. Пономарев**
Бирская государственная социально-педагогическая академия, Бирск
¹*Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Уфа*
Влияние материала электродов на спектр тока термостимулированной деполяризации полидифениленфталида
- В03. А.В. Зимин, Т.А. Юрре, В.В.Криволапчук¹, М.М. Мездрогина¹, С.М. Голубенко², М.В.Еременко²**
СПб ГТИ (ТУ), Санкт-Петербург
¹*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург*
²*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Спектры излучения фталоцианинов с редкоземельными металлами
- В04. В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов, Б.А. Логинов¹, В.А.Беспалов¹**
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН
¹*МИЭТ, Москва*
Эмиссия электронов из структур с полимерными покрытиями
- В05. А.А. Лачинов, Н.В. Воробьева¹**
Башкирский государственный университет
¹*ИФМК УНЦ РАН, Уфа*
Влияние электрического напряжения на параметры инжекционного магнетосопротивления структуры ферромагнетик/аморфный полимер/не магнитный металл
- В06. В.Х. Кудоярова, В.М. Лебедев¹, А.П. Возняковский², М.Ф. Кудояров**
Физико-технический институт им. А. Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*ПНИЯФ им. Константинова, Гатчина, Ленинградской обл.*
²*Институт синтетического каучука им. С.В.Лебедева, Санкт-Петербург*
Исследование структуры силоксановых пленок методами рассеяния нейтронов и дейтронов
- В07. А.Р. Юсупов, Р.Б. Салихов, А.Н. Лачинов¹, С.Н.Салазкин²**
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
¹*ИФМК УНЦ РАН, Уфа*
²*Институт элементоорганических соединений РАН, Москва*
Транзисторный эффект на аморфном полимерном транспортном слое
- В08. А.А. Ковалев, А.Н. Лачинов, В.А. Антипин¹**
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН
¹*Институт органической химии УНЦ РАН, Уфа*
Исследование электролюминесценции в тонких полимерных пленках с широкой запрещенной зоной

- В09. Р.Г. Рахмеев, А.Н. Лачинов, Р.Б. Салихов¹, А.Р. Тамеев²**
ИФМК УНЦ РАН, Уфа, 450000, пр. Октября 151
¹*БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, 450000, Окт.революции, д.3а*
²*ИФХЭХ им. А.Н.Фрумкина РАН Москва*
Дрейфовая подвижность носителей заряда в пленках полидифениленфталида
- В10. А.В. Мошелёв, А.Н. Лачинов¹, А.Ф. Пономарёв**
Бирская государственная социально-педагогическая академия
¹*ИФМК УНЦ РАН, Уфа*
Влияние химической структуры полимера на образование в нем ловушечных состояний
- В11. А.М. Ярыжнов, В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов**
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН
Формирование и визуализация наноскопических высокопроводящих областей в аморфной полимерной пленке
- В12. А. А. Бунаков, Р. Б. Салихов, А. Н. Лачинов¹**
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
¹*ИФМК УНЦ РАН, Уфа*
Многослойные гетероструктуры типа Si-полимер-металл
- В13. Р.Б. Салихов, А.Н. Лачинов¹, Р.Г. Рахмеев¹, Р.Г. Гадиев¹**
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
¹*ИФМК УНЦ РАН, Уфа*
Транспортный слой на границе раздела полимерных пленок
- В14. Е.А. Тузова, Е.Л. Александрова, А.Н. Алешин**
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Эффекты переключения и памяти в пленках на основе композитов полимеров с неорганическими наночастицами
- В15. И.Г.Спиридонов, Э.А.Лебедев, Е.И.Теруков**
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Эффект переключения в металлофталоцианинах редкоземельных элементов
- В16. Д.М. Жигунов², Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман¹, И.В. Подешво¹,
В.Ю. Тимошенко²**
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*ИВС РАН, Санкт-Петербург*
²*МГУ им. Ломоносова*
Собственная люминесценция Tb и Eu в металл – полимерных комплексах полиамидных кислот и теноилтрифторацетона
- В17. Т.Г. Бутхузи, А.М. Туриев**
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ
Исследование лазерно-стимулированной фрагментации пленок металлофталоцианинов вакуумно-осажденных на поверхность арсенида галлия

- B18. А.В. Анкудинов, Е.В. Гущина, М.В. Горохов, Е.Е. Терукова**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
 Диагностика каталитических слоев топливных элементов методами атомно-силовой микроскопии
- B19. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов¹, Н.М. Геллер¹, В.В. Шаманин¹**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург
 Фотофизические свойства полисалицилиденазометинов, содержащих элементы IV группы в основной цепи
- B20. Е.Л. Александрова, А.Г. Иванов¹, Н.М. Геллер¹, В.В. Шаманин¹**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург
 Закономерности изменения фотофизических свойств в гомологическом ряду металлоорганических поли(салицилиден-кобальт-нафтионат)ов
- B21. Н.М.Геллер², А.Г. Иванов², Ю.А. Николаев¹, В.Ю. Рудь³, Ю.В. Рудь¹,
 Е.И. Теруков¹, В.В. Шаманин²**
¹*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН*
²*ИВС РАН, Санкт-Петербург*
³*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
 Гетерофотоэлементы на основе новых металлоорганических полисалицилиденазометинов и алмазоподобных полупроводников (Si, GaAs)

Секция С: Аморфный углерод

- C01. A.V. Khomich¹, S.B. Guo², F.X. Lu², W.Z. Tang², V.G. Ralchenko³, N.A. Poklonski⁴, N.M. Lapchuk⁴, V.G. Baev⁴, S.A. Vyrko⁴, S. Munkhtsetseg⁵,
 A.F. Popovich¹**
¹*V.A. Kotelnikov Institute of RadioEngineering & Electronics RAS, Fryazino, Russia*
²*Beijing University of Science and Technology, Beijing, PR China*
³*A.M. Prokhorov General Physics Institute RAS, Moscow, Russia*
⁴*Belarusian State University, Physics Department, Minsk, Belarus*
⁵*National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia*
 Nitrogen in microcrystalline diamond films deposited by DC arc plasma jet
- C02. M.Gustavo Díaz Carvajal, A. Kosarev, A. Torres Jacome**
Institute National for Astrophysics, Optics and Electronics, Puebla, Mexico
 Study of porosity in carbon Films for Electronics
- C03. О.И. Коньков, А. В.Приходько¹**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
 Микрористаллы фуллерен-медь: электрическая нестабильность и статистические корреляции
- C04. А.А. Бабаев, М.Ш. Абдулвагабов¹, З.А. Агаларова¹, А.И. Косарев²**
Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского НЦ РАН
¹*Дагестанский государственный университет, Махачкала*
²*Institute National for Astrophysics, Optics and Electronics, Puebla, Mexico*

Влияние условий осаждения на электрические, теплофизические и механические свойства a-C:H

C05. Д.П. Бернацкий, В.И. Иванов-Омский, В.Г. Павлов

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Полевая электронная эмиссия с аморфного наноструктурированного углерода, покрытого цезием

Секция D: Нанокристаллические, пористые и кластерные материалы

D01. С.К. Лазарук, П.С. Кацуба, П.В. Жагиро, А.А. Лешок, А.Г. Смирнов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Стабильность электролюминесценции пористого кремния, встроенного в алюмооксидную матрицу

D02. С.К. Лазарук, Д.А. Сасинович, Т.И. Ореховская, В.Е. Борисенко

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Формирование пористого оксида титана при высоких плотностях анодного тока

D03. М.Н. Мартышов¹, П.А. Форш^{1,2}, В.Ю. Тимошенко^{1,2}, П.К. Кашкаров^{1,2}

¹*Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова*

²*РНЦ «Курчатовский институт», Москва*

Влияние температурного отжига на проводимость в слоях мезопористого кремния

D04. О.П. Виноградова¹, И.О. Попова², А.И. Сидоров¹, С.Д. Ханин²,

Е.Б. Шадрин

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

¹*Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург*

²*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,*

Нелинейные оптические свойства нанокompозитов «пористое стекло-суперионик»

D05. Е.П. Светлов-Прокопьев, С.П. Тимошенко, Л.М. Павлова

Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ)

Гипотеза о высоких эксплуатационных характеристиках наноматериалов

D06. А.А. Ковалевский, А.С. Строгова, В.А. Лабунов, А.В. Долбик

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Микро- и наноструктурные порошки кремния и их тепловые свойства

**D07. Ю.В. Рябчиков¹, А.С. Гаврилюк¹, П.А. Форш^{1,2}, М.Н. Мартышов¹,
В.Ю. Тимошенко^{1,2}, П.К. Кашкаров^{1,2}**

¹*Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова*

²*РНЦ «Курчатовский институт», Москва*

Исследование переноса носителей заряда в многослойных структурах, содержащих кремниевые нанокристаллы

D08. И.И. Парфенова

СППТИ(ТУ) им. Г.В.Плеханова, Санкт-Петербург

Микрокластеры и внутренние напряжения в GaP:N в GaAs:N твердых растворах

- D09. Н.Н. Афонин, В.А. Логачева¹, Ю.С. Шрамченко, А.М. Ховив¹**
Воронежский государственный педагогический университет
¹*Воронежский государственный университет*
Синтез и свойства нанокристаллических пленочных систем ниобия, индия и олова на монокристаллическом кремнии
- D10. С.Г. Черкова, Г.А. Качурин, Д.В. Марин, А. Misiuk¹, З.Ш. Яновицкая, J. Jedrzejewsky², I. Balberg²**
Институт физики полупроводников СО РАН
¹*Institute of Electron Technology, 02-668 Warsaw, Poland*
²*Racah Institute of Physics, Hebrew University of Jerusalem, 91904, Israel*
Влияние гидростатического давления на процессы формирования нанокристаллического кремния при отжиге слоев SiO₂:Si
- D11. А.В. Ильинский, А.И. Сидоров¹, С.Д. Ханин², Т.А. Хрущева², Е.Б. Шадрин**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹*Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург*
²*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,*
Размерные зависимости параметров фазового перехода полупроводник–металл в микрокристаллах VO₂, внедренных в пористые стеклянные матрицы
- D12. В.А.Стучинский, С.Г.Черкова, Г.А.Качурин, Д.В.Марин**
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск
Гашение фотолюминесценции в слоях окиси кремния с кремниевыми нанокристаллами под действием ионного облучения: анализ экспериментальных данных
- D13. А.А. Попов, А.А. Мироненко, А.Е. Бердников, В.Д. Черномордик, М.Д. Ефремов¹, В.А. Володин¹**
¹*Институт физики полупроводников СО РАН*
Ярославский филиал физико-технологического института РАН
Электролюминесценция пленок нитрида кремния
- D14. В.А. Терехов, К.Н. Панков, С.Ю. Турищев, В.М. Кашкаров, П.В. Середин, Э.П. Домашевская, Д.И. Тетельбаум¹, А.Н. Михайлов¹, А.И. Белов¹**
Воронежский государственный университет
¹*Нижегородский государственный университет*
Формирование нанокластеров элементарного кремния в матрице оксида кремния при отжиге плёнок SiO_x по данным XANES и USXES
- D15. В.Б. Малков¹, В.Г. Пушкин², Б.В. Шульгин³, А.В. Малков⁴, О.В. Малков⁴**
¹*Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург*
²*Институт физики металлов, УрО РАН, Екатеринбург*
³*Уральский государственный технический университет, УГТУ-УПИ, Екатеринбург*
⁴*Научно-производственный центр «РОСНА», Екатеринбург*
Эволюция ротационного искривления решетки нанотонких кристаллов селена
- D16. Е.В. Александрович, И.В. Федотова¹, М.В. Шинкевич¹**
Институт прикладной механики УрО РАН
¹*Удмуртский государственный университет, Ижевск*

Исследование возможности получения наноразмерных иглообразных структур на поверхности пленок Ge₁₀Se₉₀

D17. R. Holomb, V. Mitsa, M. Veresh¹

Research Institute for Solid State Physics and Chemistry, Uzhhorod National University

¹*Solid State Physics and Optics Institute, Budapest, Hungary*

Ring-, branchy-, and cage-like As_nS_m nanoclusters in the structure of amorphous semiconductors: ab initio and Raman study

D18. А.И. Машин, А.В. Нежданов, В.Г. Шенгуров, И.В. Услугиин

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Исследование возможности получения кремниевых кластеров методом сублимации в вакууме

D19. В.Е. Оглуздин

Институт общей физики РАН, Москва, Россия

Наблюдение в видимой области спектра фотолюминесценции наночастиц кремния, взвешенных в этаноле

D20. С.А. Аржанникова, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, Д.В. Марин, В.А. Володин, А.А. Вощенко

Институт физики полупроводников, Новосибирск

Перенос заряда через кремниевые нанокластеры, встроенные в пленки SiO_x

D21. В.Г. Литвинов, В.Г. Мишустин, В.В. Гудзев, Н.Б. Рыбин, К.О. Аношкин

Рязанский государственный радиотехнический университет

Практические аспекты применения метода DLTS для исследования электронных состояний в неупорядоченных полупроводниках

D22. С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, В.Г. Литвинов, В.Г. Мишустин, А.А. Маслов, А.В. Терехин

Рязанский государственный радиотехнический университет

Определение плотности локализованных состояний в a-Si:H по известному распределению электрического поля

D23. П.И. Воронцов

Московский энергетический институт (ТУ)

Оценка влияния размеров на вероятность перколяционных процессов в малых рабочих объемах

D24. В.И. Графутин, О.В. Илюхина, Г.Г. Мяснищева, Е.П. Светлов-Прокопьев, И.В. Калугин¹, О.М. Бритков¹, С.П. Тимошенко¹, Ю.В. Фунтиков¹

Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова, Москва

¹*МИЭТ, Москва*

Определение размеров нанобъектов в дефектных и пористых системах по данным метода позитронной аннигиляции

D25. А.С. Абрамов, Д. Дайнека, П. Рока и Кабаррокас

LPICM UMR 7647, Ecole Polytechnique, France

Исследование свойств аморфных и микрокристаллических кремниевых плёнок при помощи спектроскопической эллипсометрии

D26. П. Жагиро, П. Кацуба, С. Лазарук, А. Смирнов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Особенности измерений электрофизических характеристик диодов Шоттки на пористом кремнии

D27. А.М. Полянский, В.А. Полянский¹, Ю.А. Яковлев

ООО «НПК Электронные и Пучковые Технологии», Санкт-Петербург
¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Анализ водорода как индикатора не идеальности структур

D28. Н.Н. Афонин¹, В.А. Логачева, А.Н. Лукин, Э.А. Долгополова, Ю.А. Тихонова, А.М. Ховив

Воронежский государственный университет
¹*Воронежский государственный педагогический университет*
Синтез и оптические свойства микрокристаллических пленок на основе оксидов лантана и вольфрама

D29. Д.Н. Горячев, О.С. Ельцина*, Л.В. Беляков, О.М. Сресели

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Получение и исследование композитов нанопористый кремний- платина для топливных элементов

D30. Ж.В. Смагина, В.А. Зиновьев, А.В. Ненашев, В.А. Армбристер, А.В. Двуреченский

Институт физики полупроводников, Новосибирск
Ge-Si наноструктуры, полученные осаждением из ионно-молекулярных пучков

9 июля, 16:00

Секция Е: Халькогенидные и стеклообразные полупроводники

- Е01. В.Ю. Колосов, К.Л. Швамм, Р.В. Гайнутдинов¹, А.Л. Толстихина¹**
Кафедра физики УрГЭУ
¹*Институт кристаллографии РАН, Москва*
Комплексное исследование центров кристаллизации с «транс-ротационной» наноструктурой в аморфных пленках Se методами просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии
- Е02. В.Ю. Колосов, К.Л. Швамм, Л.М. Веретенников**
УрГЭУ, Екатеринбург
Особенности микроструктуры кристаллов теллура, растущих в аморфных пленках медь-теллур
- Е03. Е.В. Шмидт, А.Н. Борисов, В.Л. Матухин**
Казанский государственный энергетический университет
Исследование качества напыленных халькогенидных пленок методом эллипсометрии
- Е04. И.В. Чепелева**
НИИ ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова
Термический отжиг радиационных дефектов в селенидных стеклах: роль среднего координационного числа
- Е05. С.А. Немов¹, А.В. Марченко, П.П. Серегин**
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
¹*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Валентное состояние европия, гадолиния и диспрозия в стеклах
- Е06. В.А. Бордовский, И.А. Дземидко, А.В. Марченко, П.П. Серегин**
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Свойства и структура стекол $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe_2)_{z-x}(Tl_2Se)_x$ и $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe)_{z-x}(Tl_2Se)_x$
- Е07. Г.А. Бордовский, И.А. Дземидко, А.В. Марченко А.В., П.П. Серегин**
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Термическая и радиационная устойчивость валентных состояний олова в стеклах $(As_2Se_3)_{1-z}(SnSe)_{z-x}(GeSe)_x$
- Е08. Мир-Гасан Ю.Сеидов^{1,2}, Р.А. Сулейманов^{1,2}, С.С. Бабаев², Т.Г. Мамедов², А.И. Наджафов^{2,3}, Г.М. Шарифов²**
¹*Department of Physics, Gebze Institute of Technology, 41400, Gebze, Kocaeli, Turkey*
²*Институт физики НАН Азербайджана, Баку*
³*Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку*
Влияние света на диэлектрические свойства несоизмеримой фазы слоистого кристалла $TlInS_2$ с примесью La
- Е09. Г.И. Абуталыбов, Д.И. Гусейнов, А.А. Мамедов**
Институт физики НАН Азербайджана

Спектрально-люминесцентные свойства ионов в полупроводниковых стеклах состава $\text{La}_2\text{S}_3 \cdot 2,3\text{Ga}_2\text{S}_3$

- Е10. В.В. Галян, Г.Е. Давидюк, О.В. Парасюк, А.Г. Кевшин, Ю. Когут**
Волынский национальный университет имени Леси Украинки
Оптическое поглощение и фотолюминесценция стеклообразных сплавов системы $\text{Er}_2\text{Se}_3\text{-Ga}_2\text{Se}_3\text{-GeSe}_2$
- Е11. И.А. Барыгин, К. Д. Цэндин**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
Температурные зависимости концентрации дырок в полупроводнике с U-минус-центрами
- Е12. Д.И. Блещан¹, В.Н. Кабаций², А.Р. Лукьянчук¹**
¹*Ужгородский национальный университет, Украина*
²*Мукачевский технологический институт, Украина, Мукачево*
Фотоэлектрические свойства кристаллического и стеклообразного SnGeS_3
- Е13. В.В. Соболев, В. Вал. Соболев**
Удмуртский госуниверситет, Ижевск
Слабая зависимость электронной структуры диселенида германия от ближнего и дальнего порядка
- Е14. Д.П. Казакова, К.Д. Цэндин, Э.А. Лебедев, Д. Арсова¹**
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
¹*ИФТТ БАН, София*
Дрейфовая подвижность электронов и дырок в халькогенидных стеклообразных полупроводниках составов $\text{Si}_{12}\text{Ge}_{10}\text{As}_{30}\text{Te}_{48}$ и $\text{Ge}_{20}\text{As}_{20}\text{S}_{60}$
- Е15. Г.А. Бордовский, Г.И. Грабко, Р.А. Кастро, Т.В. Татуревич**
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Релаксационные процессы в пленках стеклообразного As_2Se_3
- Е16. И.Д. Толмачев, А.В. Стронский**
Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины
Оптические свойства слоев Ge-As-S
- Е17. С.П. Зимин, Е.С. Горлачев, И.И. Амиров¹**
Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова
¹*Ярославский филиал физико-технологического института РАН*
Особенности модифицирования в плазме поликристаллических пленок халькогенидов свинца на пористом кремнии
- Е18. И.В. Чепелева, К.К. Ермакович**
НИИ ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова
Парамагнитные дефекты в халькогенидных стеклах системы Ge-S-Bi с изменением типа проводимости
- Е19. Н.З. Джалилов, Н.М. Абдуллаев, Н.Р. Меммедов**
Институт физики НАН Азербайджана
Коэффициент отражения пленок системы $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$

- E20. А.И. Калугин**
Удмуртский госуниверситет
Электронная структура кристаллов ZnSe и CuBr
- E21. В.Вал. Соболев, В.В. Соболев**
Удмуртский госуниверситет
Фундаментальные спектры кристалла CuGaS₂
- E22. Б.Т. Мелех, Л.А. Кулакова, В.И. Бахарев, А.П. Данилов, С.А. Грудинкин**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Стеклообразование и свойства аморфных сплавов системы Ge-Te-Se-S
- E23. Г.А. Бордовский, Н.И. Анисимова, Р.А.Кастро, А.В. Марченко, П.П. Серегин**
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
Фотоструктурные перестроения стекол As-S и As-Se
- E24. В.Я.Когай**
Институт прикладной механики УрО РАН
О кинетике релаксации упругих напряжений в наноразмерной пленке Se
- E25. А.Г. Никитина, В.В. Зуев**
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
Применение методики термостимулированных токов для определения характера локализации электронов на дефектном центре
- E26. А.Г. Никитина, В.В. Зуев**
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
Влияние перезарядки бистабильных центров на характеристики ТСТ
- E27. А.Г. Колосько, Е.И. Теруков, В.Л. Берковец**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Поляризованные электронные переходы в спектрах анизотропного отражения тонких пленок металлофталоцианинов
- E28. Ю.В. Ануфриев**
Московский энергетический институт (Технический университет)
Определение параметров материала из вольт-амперных характеристик элементов памяти с фазовыми переходами
- E29. Е.М. Еганова**
Московский энергетический институт (технический университет)
Электропроводность стеклообразных пленок As₂Se₃ с nano частицами золота в сильных электрических полях

Секция F: Технические приложения

- F01. М.Д. Ефремов¹, В.А. Володин¹, Д.В. Марин¹, С.А. Аржанникова¹, С.П. Бардаханов²**
¹ *Институт физики полупроводников, Новосибирск, Россия*
² *Институт теоретической и прикладной механики, Новосибирск*
Нанопорошок кремния с яркой фотолюминесценцией в красно-голубой области излучения света

- F02. А.В.Медведев, А.А.Дукин, С.Ф.Каплан, Д.А.Курдюков, А.Б.Певцов, В.Г. Голубев**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Пленочные трехмерные фотонные кристаллы на основе композита опал- Er_2O_3 - Y_2O_3 -a-Si: синтез и излучательные свойства
- F03. А.В.Щербаков, А.С.Саласюк, С.Ф.Каплан, А.В.Акимов, В.Г.Голубев**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Оптические свойства трехмерных фотонных кристаллов на основе проводящих аморфно-нанокристаллических композитов
- F04. С.Е. Никитин, Э.А. Лебедев, Э.А. Сморгонская, Е.И. Теруков**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Эффект ограничения тока в структурах Si-SiO₂-Fe
- F05. Н.С. Грушко, В.В. Светухин, А.П. Солонин**
Ульяновский государственный университет
Влияние g-облучения на характеристики нитридогаллиевых светодиодов
- F06. В.М. Калыгина, А.В. Тяжев, Т.М. Яскевич**
Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова
Твердотельные преобразователи изображения на основе структур GaAs/ZnS
- F07. Н.Н. Абдулзаде, Ш.М. Гасанли, А.Я. Гусейнли, Н.Н. Мурсакулов**
Институт физики национальной академии наук Азербайджана
Электрофизические характеристики композитных нелинейных резисторов на основе полимера и кремния
- F08. Н.В. Вишняков, С.П. Вихров, В.Г. Мишустин, А.П. Авачев, И.Г. Уточкин, Е.И. Дивущак, А.А. Попов**
Рязанский государственный радиотехнический университет
Формирование квазиомических контактов в тонкопленочных устройствах на аморфных полупроводниках
- F09. Д. Мелебаев, В.М. Саркисова, А.Х. Эекова**
Туркменский государственный университет им. Магтымгулы
Спектр фоточувствительности барьера Шоттки золото—кремний, полученного методом химического осаждения
- F10. М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Э.Ю. Даниловский, Р.В. Кузьмин, С.В. Разумов¹, С.А. Кукушкин², А.Н. Осипов²**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
¹С-ПбГЭТУ, Санкт-Петербург
²Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
Влияние материала подложки на интенсивность излучения гетероструктур на основе пленок ZnO
- F11. А.А. Ковалевский, А.С. Строгова, А.В. Долбик**
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Закономерности начальных стадий формирования германосиликатного стекла в результате окисления пленок поликристаллического кремния, легированного германием

F12. А.А. Андреев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
РЗМ³⁺ ионы как внутрицентровые излучатели в матрице а-nc-GaN

F13. Г.А. Ильчук¹, Ю.А. Николаев, Р.Ю. Петрусь¹, В.Ю. Рудь², Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия
¹*Национальный университет "Львовская Политехника", Львов, Украина*
²*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Новые фоточувствительные структуры на кристаллах Cd_{1-x}Mn_xTe

F14. N.V. Garonenko, Y.V. Hluzd, S. Dabboussi¹, H. Elhouichet¹, C. Bouzidi¹, M. Oueslati¹, I.S. Molchan², G.E. Thompson²

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Minsk
¹*Unité de recherche de Spectroscopie Raman, Département de Physique, Faculté des Sciences de Tunis, Tunis*
²*Corrosion and Protection Centre, School of materials, The University of Manchester, Manchester, UK*
Room-temperature photoluminescence from porous anodic alumina films with Eu and Tb deposition

Секция G: Сопутствующие материалы

G01. И.В. Боднарь, И.А. Викторов¹

Department of Chemistry, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
¹*SSPA "Scientific-Practical Materials Research Centre of NAS of Belarus Minsk*
Исследование взаимодействия в системе CuInSe₂-2MnSe

G02. И.В. Боднарь, И.А. Викторов¹, В.Ф. Гременок

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
¹*SSPA "Scientific-Practical Materials Research Centre of NAS of Belarus Minsk*
Получение и свойства пленок тройного соединения CuIn₃Se₅

G03. С.П. Тимошенко, В.В. Калугин, И.М. Бритков, Ал.С. Тимошенко, О.М. Бритков, Д.К. Григорьев, Ан.С. Тимошенко, С.С. Евстафьев, Е.П. Светлов-Прокопьев

Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ)
Моделирование процессов роста и легирования эпитаксиальных слоев кремния в хлоридных и гидридном процессах

G04. О.Б. Тагиев, Х.Б. Ганбарова

Институт физики НАН Азербайджана
Спектры рамановского рассеяния кристаллов Ga₂S₃:Sm²⁺

G05. Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, С. А. Абушов, Г.Ю. Эйюбов

Институт физики НАН Азербайджана
Инжекционные токи монокристаллов GaS: Er, Yb

- G06. В.В. Малютина-Бронская, В.Б. Залесский, Т.Р. Леонова, А.В. Мудрый¹**
ГНУ «Институт физики им. Б. И. Степанова» НАН Беларуси
¹*ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск*
Оптические и электрические характеристики пленок ZnO легированных редкоземельными элементами
- G07. Ю.В. Рябчиков, Н.В. Васильева¹, В.В. Рандошкин¹, А.В. Платонова**
Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова
¹*Институт общей физики им. А.Н. Прохорова РАН*
Исследование фотолюминесценции Ti^{3+} в эпитаксиальных пленках гадолиний-галлиевого граната
- G08. К.В. Жерикова, Б.М. Аюпов, Н.Б. Морозова, И.К. Игуменов**
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
Осаждение пленок HfO_2 методом MOCVD
- G09. Т.В. Ким, Н.В. Гапоненко**
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Влияние компонентов на морфологию и кристаллическую структуру пленок титаната бария-стронция, формируемых золь-гель методом
- G10 Т. Леонова, В. Кравченко, В. Залесский, А. Ходин**
Институт физики, национальная академия наук Беларуси
Кратковременный отжиг на воздухе плёнок оксида ванадия
- G11. E.P.Domashenskaya, P.V.Seredin, A.V. Glotov, N.N. Gordienko, I.N.Arsentyev¹,
I.S.Tarasov¹, M.V. Shishkov¹**
Voronezh State University
¹*Ioffe Physical and Technical Institute, St-Petersburg*
Role of the buffer porous layer and dysprosium doping in GaInP:Dy/por-GaAs/GaAs(100) heterostructures
- G12. E.P. Domashenskaya, P.V. Seredin, N.N. Gordienko, N.A. Romyantseva,
B.L. Agapov, I.N. Arsent'ev¹, I.S. Tarasov¹**
Voronezh State University
¹*Ioffe Physical and Technical Institute, St-Petersburg*
Composition and parameters of domain formed as a result of spinodal decomposition of quaternary alloys in the epitaxial GaInP/InGaAsP/GaInP/GaAs(001) heterostructures
- G13. E. P. Domashenskaya¹, N. M. A. Hadia^{1,2}, P. V. Seredin¹, S. V. Ryabtsev¹**
¹*Voronezh State University*
²*Department of physics, Faculty of Science, Sohag University, Egypt*
Morphological, structural and optical study of SnO_2 nanowires synthesized from SnO powder